Family list
2 family member for:
JP10308277
Derived from 1 application.

1 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT Publication info: JP2940514B2 B2 - 1999-08-25 JP10308277 A - 1998-11-17

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Also published as:

JP10308277 (A)



# ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Patent number:

JP10308277

**Publication date:** 

1998-11-17

Inventor:

AZUMAGUCHI TATSU; ISHIKAWA HITOSHI; ODA

ATSUSHI

Applicant:

**NEC CORP** 

Classification:

international:

H05B33/14; C09K11/06

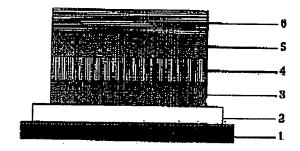
- european:

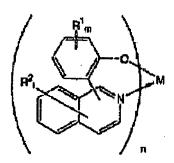
Application number: JP19970116979 19970507

Priority number(s):

## Abstract of **JP10308277**

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the light emission luminance, and to improve the stability at the time of use by adding ohydroxyphenyl isoquinoline compound as single or a mixture with other material to a layer to be pinched between a pair of conductive layers. SOLUTION: o-hydroxyphenyl isoquinoline compound is expressed with a formula. In the formula, M means n-valency metal ion, R<1> R<3> means substituent or non-substituent alkyl group, a substituent or non-substituent aryl group, halogen group, nitro group, cyano group, aryl group, a substituent or non-substituent amino group, mercapto group, hydroxyl group, carboxyl group, a substituent or non-substituent alkoxyl group, a substituent or non-substituent alkoxylcarbonyl group. (n) means 1-4, (m) means 0-4, (I) means 0-6. A metal complex with various metal ion is formed so as to be used for any one of a light emitting layer 4, an electron transporting layer 5, a positive hole transporting light emitting layer 7 and an electron transporting light emitting layer 8.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号

特開平10-308277

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

(51)IntCl.

戲別配号

FΙ

H05B 33/14 C09K 11/06 H05B 33/14

C09K 11/06

Z

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出顧番号

特願平9-116979

(22)出顧日

平成9年(1997)5月7日

(71)出頭人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 東口 達

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 石川 仁志

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 小田 敦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

## (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント案子

### (57)【要約】

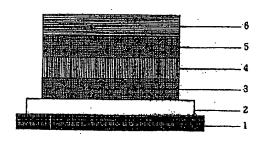
【課題】 高輝度かつ安定性に優れた有機EL素子を提供する。

【解決手段】 一般式(1)

[11]



(式中、Mはn価の金属イオンを表す。R¹、R¹は置換または無置換のアルキル基、置換または無置換のアリール基、ハロゲン、ニトロ基、シアノ基、アリル基、置換または無置換のアミノ基、メルカブト基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、置換または無置換のアルコキシル基、置換または無置換のアルコキシル基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基を表す。nは1~4、mは0~4、1は0~6のそれぞれいづれか。)で表されるo-ヒドロキシフェニルイソキノリン金属錯体を含む薄膜層を用いて索子を作製する事により、高輝度発光が得られると共に、安定性に優れた有機EL素子が得られる。



### 【特許請求の範囲】

[請求項1] 一対の導電層間に、少なくとも発光層を含 有する有機エレクトロルミネッセント素子において、前 記導電層間に挟持される層に、一般式(1)で示される o-ヒドロキシフェニルイソキノリン化合物を単独、も しくは他の材料と混合して含有するととを特徴とする有 機エレクトロルミネッセント素子。

### 【化1】

(式中、Mはn価の金属イオンを表す。R¹、R¹は置 換または無置換のアルキル基、置換または無置換のアリ ール基、ハロゲン、ニトロ基、シアノ基、アリル基、置 換または無置換のアミノ基、メルカプト基、ヒドロキシ ル基、置換または無置換のアルコキシカルボニル基を表 す。nは1~4、mは0~4、1は0~6のそれぞれい づれかを示す。)

「請求項2] 金属錯体を形成する金属としてはアルミニ ウム、マグネシウム、ベリリウム、ケイ素、スカンジウ ム、チタニウム、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、 コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ガリウム、ルテニウ ム、パラジウム、銀、カドミウム、インジウム、スズ、 ランタノイド元素、アクチノイド元素のいずれかより選 ばれる材料であることを特徴とする請求項1記載の有機 30 エレクトロルミネッセント素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、平面光源や表示素 子に利用される有機エレクトロルミネッセント(EL) 素子に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】Eし素子は、自発光型の平面型表示素子 としての用途が有望視されている。中でも有機物質を用 つ高電圧が必要といった制約がなく、また有機化合物の 多様性により、多色化が容易であると考えられることか ら、盛んに開発が行われている。

【0003】しかし、従来の有機EL素子は、無機EL 素子に比べて発光輝度が低く、特性劣化が着しかったた め、実用化には至っていなかった。近年、10 V以下の 低電圧で発光する高い発光効率を持った、有機化合物の 薄膜積層型の有機EL索子が報告され、感心を集めてい る (アプライド・フィジックス・レターズ (Appli ed Physics Letters)、51巻、9 50 する。o-ヒドロキシフェニル基の位置は特に限定され

13頁、1987年参照)。

【0004】との方法では、金属キレート錯体を蛍光体 薄膜層、アミン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝 度の緑色発光を得ており、6~7. Vの直流電圧で輝度は 数100cd/m² 、最大発光効率は1.511m/W を達成して、実用領域に近い性能を持っている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】現在までの有機EL素 子は構成、材料の改善により発光輝度は改良されている 10 が、未だ充分な発光輝度には達していない。また、素子 の寿命に関しても同様で、実用に十分な安定性を有する ものは得られていない。従って、より大きな発光輝度と 優れた使用時安定性を併せ持つ、有機EL素子の開発が 望まれているのが現状である。

[0006]本発明は、発光輝度が大きく、使用時の安 定性に優れた有機EL素子を提供することを目的とする ものである。

#### [0007]

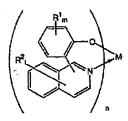
【課題を解決するための手段】本発明者らは、発光輝度 ル基、カルボキシル基、置換または無置換のアルコキシ 20 が大きく、使用時の安定性に優れた有機EL素子の構成 を見出すべく鋭意検討を重ねた結果、特定の化合物を有 機EL素子に含有させることにより、これらの要件を満 たした有機EL素子が得られる事を見出した。

> [0008] すなわち、本発明は一対の導電層間に、少 なくとも発光層を含有する有機エレクトロルミネッセン ト素子において、導電層間に挟持される層に、一般式 (1) で示される o ーヒドロキシフェニルイソキノリン 化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッ

セント素子を提供する事を目的とするものである。

# [0009]

#### [{k2}



【0010】(式中、Mはn価の金属イオンを表す。R いた有機EL素子は、無機ELのような、交流駆動でか 40  $^1$  、 $R^1$  は置換または無置換のアルキル基、置換または 無置換のアリール基、ハロゲン、ニトロ基、シアノ基、 アリル基、置換または無置換のアミノ基、メルカプト 基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、置換または無置 換のアルコキシル基、置換または無置換のアルコキシカ ルポニル基を表す。nは1~4、mは0~4、1は0~ 6のそれぞれいづれかを示す。)

【0011】以下、本発明を詳細に説明する。

【0012】本発明に用いられる0-ヒドロキシフェニ ルイソキノリンは、種々の金属イオンと金属錯体を形成

るものではない。金属錯体を形成する金属としてはアル ミニウム、マグネシウム、ベリリウム、ケイ素、スカン ジウム、チタニウム、パナジウム、クロム、マンガン、 鉄、コパルト、ニッケル、銅、亜鉛、ガリウム、ルテニ ウム、パラジウム、銀、カドミウム、インジウム、ス ズ、ランタノイド元素、アクチノイド元素が挙げられる がこれらに限られるものではない。

【0013】図1~5に、本発明の有機EL素子の構造 例の断面図を模式的に示す。1は基板、2は陽極となる 伝導層、3は正孔輸送層、4は発光層、5は電子輸送 届、8は陰極となる導電層、7は正孔輸送性発光層、8 は電子輸送性発光層をそれぞれ表している。

【0014】前記一般式(1)で表される金属錯体は、 発光層4、電子輸送層5、正孔輸送性発光層7、電子輸 送性発光層8のいずれにも用いても高輝度な安定性の高 い有機EL素子を得る事ができる。また、前記金属錯体 は発光層4、電子輸送層5、正孔輸送性発光層7、電子 翰送性発光層8のいずれかに含まれていれば、同一素子 内の別の層に含まれていなくても良い。

【0015】基板1は本発明の有機EL索子の支持体と 20 なるものであり、石英やガラスの板、金属板、樹脂フィ ルムや樹脂プレート等が用いられる。

【0016】基板1上の陽極となる導電層2には、通 常、アルミニウム、パナジウム、鉄、コパルト、ニッケ ル、タングステン、パラジウム、テルル、銀、金等の金 属、およびそれらの合金、酸化インジウム、酸化スズ等 の金属酸化物やヨウ化銅、炭素、あるいは導電性高分子 などにより構成される。導電層の形成は真空蒸着法、ス バッタリング法などの乾式成膜法で行われる事が多い が、適当なバインダー樹脂溶液に上記電極材料を分散さ 30 せてディップコート法やスピンコート法などの湿式成膜 法も使用できる。この際、使用する溶剤には、特に制限 は無い。さらに、導電性高分子の場合は、電界重合によ り直接基板上に薄膜を形成する事も可能である。この導 電層は複数の薄膜によって形成する事も可能である。

【0017】陰極となる導電層6には、前記導電層2用 の材料を用いる事が可能であるが、効率よく電子注入を 行う必要があるため、スズ、マグネシウム、インジウ ム、アルミニウム、銀等の金属またはそれらの合金が好 ましい。この導電層6も導電層2と同様、複数の薄膜に 40 よって形成する事も可能である。

【0018】導電層2、6共に特に膜厚に制限は無い が、発光した光を基板に垂直な方向に取り出す場合、少 なくとも一方の導電層の透光率は60%以上、好ましく は80%以上であることが望ましい。この場合、厚みは 通常5~1000nm、好ましくは10~500nm程 度である。

【0019】正孔翰送暦3には、種々の正孔翰送材料が 用いられる。この正孔翰送材料としては、導電層2から

も高いものが望ましい。とのような正孔翰送材料として は、公知の各種正孔翰送材料が使用可能である。例え ば、低分子材料としてはトリフェニルアミン、ビストリ フェニルアミンなどの芳香族アミン系化合物やヒドラゾ ン系化合物等が挙げられる。また、高分子材料としては ポリピニルカルパゾールや、特開平8-54833号公 報、特開平8-269133号公報に示される芳香族ア ミン系骨格を側鎖にもつ高分子も使用可能である。ま

た、正孔翰送性を持つ無機材料を使用する事もできる。 10 これらの材料、化合物は、単独でも混合でも用いる事が できる。また、必要に応じて適当なパインダー樹脂中に 分散させた状態でも用いる事が可能である。バインダー 樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポ リエステルなどが挙げられる。髙分子正孔輸送材料をバ インダーとして用いることも可能である。

【0020】上記の正孔翰送材料は、真空蒸着法、塗布 法により形成される。いずれの場合も、正孔輸送性、正 孔注人性、成膜性を向上させるために各種添加剤を添加 して用いても良い。

【0021】一般式(1)で表される金属錯体材料は、 単独でも他の材料との混合でも、使用可能である。混合 する材料としては、種々の材料が使用可能である。発光 層4に用いる場合には、アントラセン、ナフタレン、ス チルベン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、ピフ ェニル及びそれらの誘導体等の蛍光材料、ベンゾフラン 誘導体、クマリン誘導体等の色素があげられるが、これ らに限定されるものではない。電子輸送層5に用いる場 合には、オキサジアゾール誘導体やトリアゾール誘導体 などの有機電子輸送材料、キノリノールアルミニウム錯 体等の金属錯体化合物、n型水素化アモルファスシリコ ンカーバイド、n型硫化亜鉛などの無機電子輸送材料な どが挙げられるが、これらに限定されるものではない。 正孔翰送性発光層7に用いる場合には正孔翰送層3に用 いる材料と発光層4に混合可能な材料のいずれも用いる ととが可能である。電子輸送性発光層8に用いる場合に は、電子輸送層5に用いる材料と発光層4に用いる材料 のいずれも用いる事が可能である。

【0022】発光層4、電子輸送層5、正孔輸送性発光 **届7、電子輸送性発光層8はいずれも、正孔輸送層3と** 同様の方法で形成される。

[0023]

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明につい て、更に具体的に説明するが、本発明は、その主旨を越 えない限り以下の実施例に限定されるものではない。

【0024】(製造例1-10)

1- (o-ヒドロキシフェニル) - イソキノリンはGe issmanゟの方法(ジャーナル・オブ・オーガニッ ク・ケミストリ、11巻、741買、1946年) に従 い合成した。これを用い、W. D. Johnstonと の正孔の注入効率が高いと同時に、正孔を輸送する能力 50 H. Freiserの手法(ジャーナル・オブ・ザ・ア

メリカン・ケミカル・ソサイエティ、74巻、5239 買、1952年)に従って、表1に示した金属原子を含 有した、1-(o-ヒドロキシフェニル)-イソキノリ ン金属錯体を合成した。

[0025]

## 【表1】

製造例	金属
1	アルミニウム
2	鉄
3	<b>1</b>
4	クロム
5 8	亜鉛
- 6	ニッケル
7	コパルト
8	セリウム
9	ランダン
10	水銀

[0026]

## 【実施例】

(実施例1)洗浄した1丁〇電極付きガラス板上に、 4、4 '-ピス (N- (1-ナフチル) -N-フェニル アミノ〉ピフェニルを真空蒸着して膜厚60 nmの正孔 輸送層を得た。次いで、1-(0-ヒドロキシフェニ て20nmの発光層を得た。その上に8-ヒドロキシキ ノリンアルミニウム金属錯体を真空蒸着して50nmの 電子輸送層を得た。さらにその上に、マグネシウムと銀 を10:1で混合した合金で膜厚200mmの導電層を 形成して、図1に示す有機EL素子を得た。との素子は 良好な有機EL発光特性を示した。また1000時間連 統発光させた後も、初期と変わらない良好な発光特性を 示した。

【0027】(実施例2-10)1-(o-ヒドロキシ フェニル)-イソキノリンアルミニウム金属錯体に代え 30 て発光層に製造例2~10で得られた1-(o-ヒドロ キシフェニル) - イソキノリン金属錯体を使用する以外 は、実施例1と同様の方法で有機EL素子を作製した。 とれらの素子はいずれも良好な有機E L 発光特性を示し た。また1000時間連続発光させた後も、初期と変わ らない良好な発光特性を示した。

【0028】 (実施例11) 洗浄した ITO電極付きガ ラス板上に、4、4 '-ビス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ) ピフェニルを真空蒸着して膜厚6 0 n mの正孔輸送層を得た。次いで、1-(o-ヒドロ キシフェニル) - イソキノリンアルミニウム金属錯体を 真空蒸着して50nmの電子輸送性発光層を得た。その 上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金で膜 厚200nmの導電層を形成して、図2に示す有機EL 素子を得た。この素子は良好な有機EL発光特性を示し た。また1000時間連続発光させた後も、初期と変わ らない良好な発光特性を示した。

[0029] (実施例12-20) 1-(o-ヒドロキ シフェニル) - イソキノリンアルミニウム金属錯体に代 えて発光層に製造例2~10で得られた1-(o-ヒド 50 -(o-ヒドロキシフェニル)-イソキノリンアルミニ

ロキシフェニル) - イソキノリン金属錯体を使用する以 外は、実施例11と同様の方法で有機EL素子を作製し た。これらの素子はいずれも良好な有機EL発光特性を 示した。また1000時間連続発光させた後も、初期と 変わらない良好な発光特性を示した。

【0030】(実施例21)洗浄した1TO電極付きガ ラス板上に、4、4 '-ピス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ) ビフェニルと1- (o-ヒドロキ シフェニル) - イソキノリンアルミニウム金属錯体を真 10 空蒸着して膜厚60 n mの正孔輸送性発光層を得た。次 いで8-ヒドロキシキノリンアルミニウム金属錯体を真 空蒸着して50mmの電子輸送圏を得た。さらにその上 に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金で膜厚 200 nmの導電層を形成して、図3に示す有機EL素 子を得た。この素子は良好な有機EL発光特性を示し た。また1000時間連続発光させた後も、初期と変わ らない良好な発光特性を示した。

[0031] (実施例22-30) 1-(o-ヒドロキ シフェニル) - イソキノリンアルミニウム金属錯体に代 ル) -イソキノリンアルミニウム金属錯体を真空蒸着し 20 えて発光層に製造例2~10で得られた1-(o-ヒド ロキシフェニル) - イソキノリン金属錯体を使用する以 外は、実施例21と同様の方法で有機EL素子を作製し た。とれらの素子はいずれも良好な有機EL発光特性を 示した。また1000時間連続発光させた後も、初期と 変わらない良好な発光特性を示した。

> 【0032】(実施例31)洗浄したITO電極付きガ ラス板上に、4、4 '-ビス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ) ピフェニルと1- (o-ヒドロキ シフェニル) - イソキノリンアルミニウム金属錯体を真 空蒸着して膜厚70nmの正孔輸送性発光層を得た。次 いてマグネシウムと銀を10:1で混合した合金で膜厚 200nmの導電層を形成して、図4に示す有機EL素 子を得た。この素子は良好な有機EL発光特性を示し た。また1000時間連続発光させた後も、初期と変わ ちない良好な発光特性を示した。

【0033】(実施例32-40)1-(o-ヒドロキ シフェニル) - イソキノリンアルミニウム金属錯体に代 えて発光層に製造例2~10で得られた1-(o-ヒド ロキシフェニル) - イソキノリン金属錯体を使用する以 40 外は、実施例31と同様の方法で有機EL素子を作製し た。 これらの素子はいずれも良好な有機EL発光特性を 示した。また1000時間連続発光させた後も、初期と 変わらない良好な発光特性を示した。

【0034】(実施例41)洗浄した「TO電極付きガ ラス板上に、4、4 '-ビス(N-(l-ナフチル)-N-フェニルアミノ) ピフェニルを真空蒸着して膜厚6 Onmの正孔輸送層を得た。次いで、8-ヒドロキシキ ノリンアルミニウム金属錯体とテトラフェニルブタジエ ンを真空蒸着して20 nmの発光層を得た。その上に1

ウム金属錯体を真空蒸着して50 nmの電子輸送層を得 た。さらにその上に、マグネシウムと銀を10:1で混 合した合金で膜厚200nmの導電層を形成して、図1 に示す有機EL素子を得た。この素子は良好な有機EL 発光特性を示した。また1000時間連続発光させた後 も、初期と変わらない良好な発光特性を示した。

【0035】(実施例42-50)1-(o-ヒドロキ シフェニル) - イソキノリンアルミニウム金属錯体に代 えて発光層に製造例2~1.0で得られた1-(o-ヒド ロキシフェニル) - イソキノリン金属錯体を使用する以 10 2 陽極となる導電層 外は、実施例21と同様の方法で有機EL索子を作製し た。これらの索子はいずれも良好な有機EL発光特性を 示した。また1000時間連続発光させた後も、初期と 変わらない良好な発光特性を示した。

[0036]

[発明の効果] 本発明により、高輝度であり安定性に優米

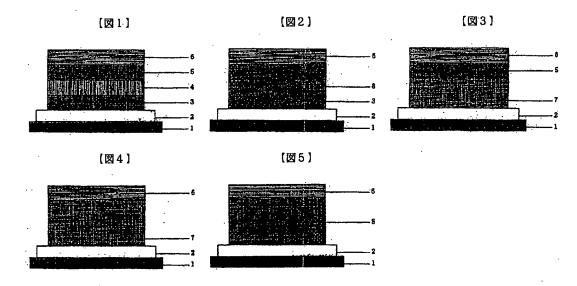
\*れた有機EL索子を得る事ができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】有機EL素子の概略構造を表す断面図である。
- 【図2】有機EL素子の概略構造を表す断面図である。
- 【図3】有機EL素子の概略構造を表す断面図である。
- 【図4】有機EL素子の概略構造を表す断面図である。
- 【図5】有機EL素子の概略構造を表す断面図である。 【符号の説明】

# 1 支持基板

- - 3 正孔翰送層
  - 4 発光層
  - 5 電子輸送層
  - 6 陰極となる導電層
  - 7 正孔翰送性発光層
  - 8 電子輸送性発光層



BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)